

## Tehnologie de fabricatie structuri metalice interdigitate

Etapele fluxului tehnologic au fost urmatoarele (*Tehnologie de fabricatie structuri metalice interdigitate*):

- Curatarea chimica a substratului ( $\text{HfO}_2/\text{GeSiHfO}_2/\text{HfO}_2/\text{Si}$ );
- Realizarea procesului de fotogravura care a constat in:
  - Etalarea fotorezistului;
  - Expunerea prin masca fotolitografica a rezistului (M1-folosita pentru primul substrat si M2-utilizata pentru suportul numarul 2);
  - Developarea fotorezistului.
- Depunerea prin evaporare a filmului metalic ( $\text{Cr}/\text{Au}$ ) cu grosimea de 10/100 nm, folosind sistemul TEMESCAL FC-2000, USA;
- Flux tehnologic proces lift-off (Fig.1).
- Exemple realizare structure metalice interdigitate

<p>Substrat-Si</p> <p>Fotorezist</p> <p>Substrat-Si</p> <p>Fotorezist</p> <p>Substrat-Si</p> <p>Au</p> <p>Fotorezist</p> <p>Substrat-Si</p> <p>dizolvare fotorezist</p> <p>Substrat-Si</p> <p>Au</p> <p>Substrat-Si</p>	<p>(a)</p> <p>(b)</p>
<p>Fig. 1. Fluxul tehnologic pentru procesul lift-off - pentru un strat metalic de Au, utilizand fotorezist pozitiv</p>	<p>Fig. 2. Imagini optice ale structurilor test: (a) din fotorezist (dupa procesul de developare) - latimea digit/interdigit-200 <math>\mu\text{m}</math>; (b) dupa procesul lift-off - latimea digit/interdigit- 100 <math>\mu\text{m}</math>;</p>

**Potentiale aplicatii:** fotonica, biosenzori, etc.